

2SK532

シリコンNチャンネルMOS形電界効果トランジスタ(π -MOS II)

- 高速大電流スイッチング用
- DC-DC コンバータ用
- モータドライブ用

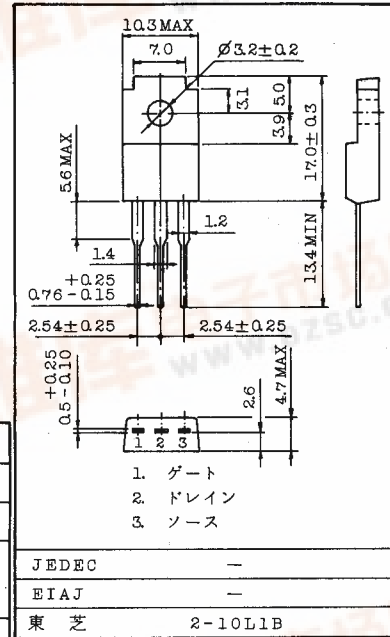
特長

- ・ オン抵抗が低い。: $R_{DS(ON)} = 0.07\Omega$ (標準)
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い。: $|Y_{fs}| = 5S$ (標準) ($I_D = 6A$)
- ・ 漏れ電流が低い。: $I_{GSS} = \pm 100nA$ (最大) ($V_{GS} = \pm 20V$)
 $I_{DSS} = 1mA$ (最大) ($V_{DS} = 60V$)
- ・ 取扱いが簡単な, エンハンスメントタイプです。
- ・ 絶縁プッシング, マイカ等が不要な T0-220 相当のアイソレーションパッケージです。

最大定格 (Ta = 25°C)

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSX}	60	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	± 20	V
ドレイン電流	DC	I_D	12
	パルス	I_{DP}	25
許容損失	P_D	Ta = 25°C	2.0
		Tc = 25°C	4.0
チャンネル温度	T_{ch}	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	°C

通信工業用
単位: mm



電気的特性 (Ta = 25°C)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0$	—	—	± 100	nA
ドレインしゅ断電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0$	—	—	1.0	mA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 10mA, V_{GS} = 0$	60	—	—	V
ゲートしきい値電圧	V_{th}	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$	1.5	—	3.5	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 10V, I_D = 6A$	2	5	—	S
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D = 6A, V_{GS} = 10V$	—	0.070	0.085	Ω
ドレイン・ソース間オン電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D = 12A, V_{GS} = 10V$	—	0.9	1.1	V
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	930	1300	pF
帰 還 容 量	C_{rss}	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	400	700	pF
出 力 容 量	C_{oss}	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	980	1400	pF
スイッチング時間	上昇時間	t_r	—	100	200	ns
	ターンオン時間	t_{on}	—	120	240	
	下降時間	t_f	—	110	220	
	ターンオフ時間	t_{off}	—	190	380	

10V 入力, 10µs, 50Ω, $I_D = 6A$, 出力, $V_{DD} = 30V$, 繰り返し周期 ≤ 1%, 入力: $t_r, t_f < 5ns (Z_{out} = 50\Omega)$

この製品は MOS 構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。

